

**摘要**

本用户指南介绍了 TPSM846C23DEVM-807 评估模块 (PWR807) 的信息。本文件还包括 EVM 的性能规格、原理图、物料清单 (BOM) 和布局。

内容

1 说明.....	2
2 入门.....	2
3 测试点说明.....	4
4 操作说明.....	5
5 性能数据.....	6
6 原理图.....	7
7 物料清单.....	8
8 PCB 布局.....	9
9 修订历史记录.....	11

插图清单

图 2-1. EVM 用户接口.....	2
图 5-1. 效率.....	6
图 5-2. 功率耗散.....	6
图 5-3. 输出电压纹波.....	6
图 6-1. TPSM846C23DEVM-807 原理图.....	7
图 8-1. 顶部元件.....	9
图 8-2. 顶部覆铜.....	9
图 8-3. 第 2 层覆铜.....	9
图 8-4. 第 3 层覆铜.....	9
图 8-5. 第 4 层覆铜.....	10
图 8-6. 第 5 层覆铜.....	10
图 8-7. 底部覆铜.....	10
图 8-8. 底部元件.....	10

表格清单

表 3-1. 测试点.....	4
表 7-1. TPSM846C23DEVM-807 物料清单.....	8

商标

PMBus™ is a trademark of SMIF, Incorporated.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 说明

TPSM846C23 是一款支持 PMBus™ 的同步降压电源模块，可提供高达 35A 的输出电流。TPSM846C23 可与两个 TPSM846C23 器件并联，实现高达 70A 的输出电流。TPSM846C23 是一款支持 PMBus 的高度集成的直流/直流电源模块，在一个扁平封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 35A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器、一些输入和输出电容器以及无源器件。输入电压范围为 4.5V 至 15V。输出电压范围为 0.35V 至 2V。PMBus 接口支持转换器配置、主要参数（包括输出电压、输出电流和内部裸片温度）监控以及许多用户可编程的配置选项。

该评估模块旨在展示并联两个 TPSM846C23 电源模块时可实现的易用性和小型印刷电路板面积。通过提供监控测试点，可测量以下参数：

- 效率
- 功率耗散
- 输入纹波
- 输出纹波
- 线性和负载调整率
- 瞬态响应

此外，还提供了控制测试点，以便使用器件的电源正常和同步特性。EVM 采用推荐的 PCB 布局，可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。

2 入门

图 2-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。极化输入电源端子块 (TB1) 用于连接到主机输入电源。TB2 和 TB3 允许四个端子用于 VOUT，TB4 和 TB5 允许四个端子用于 PGND 以连接到负载。这些端子块可接受高达 12 AWG 的导线。

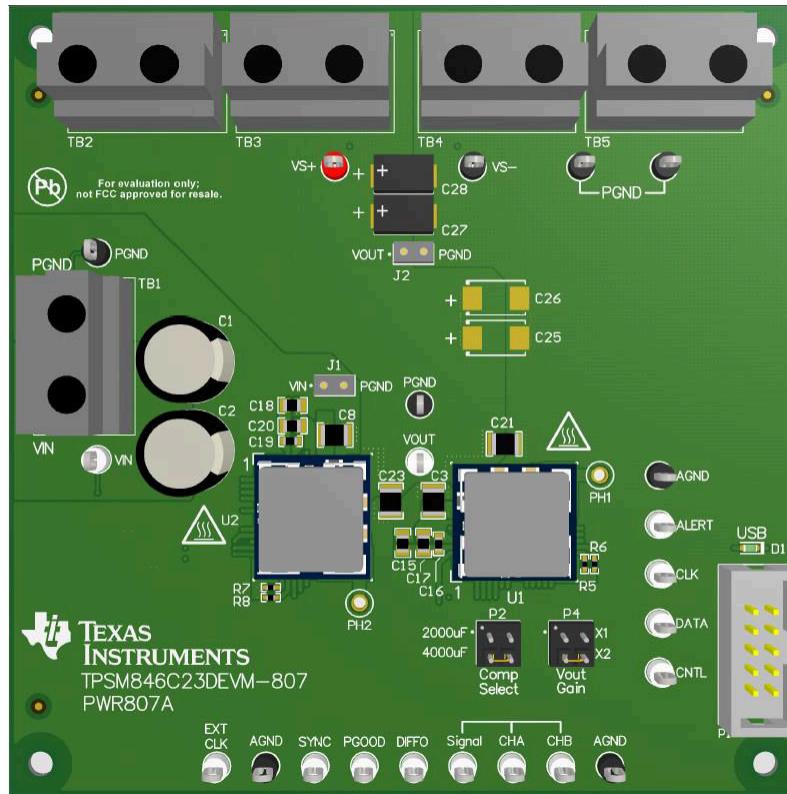


图 2-1. EVM 用户接口

位于输入端子块和输出端子块附近的 VIN 监测器 (VIN 和 PGND) 和 VOUT 监测器 (VS+ 和 VS-) 测试点旨在用作电压监测点，可以连接电压表来测量输入和输出电压。请勿将这些 VIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线无法支持高电流。

VIN 范围 (J1) 和 VOUT 范围 (J2) 测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点适用于配有低电感接地引线 (接地弹簧 , 安装到桶式示波器探针) 的无帽示波器探针。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。示波器探头尖端应插入标有 VIN 或 VOUT 的插座 , 示波器探头接地引线应插入标有 PGND 的插座的孔中。

位于器件正下方的测试点可用于测试器件的特性。对这些测试点进行的任何外部连接都应以位于 EVM 底部的某个 AGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息 , 请参阅 [节 3](#)。

提供 PMBus 连接器 (P1) , 以便将 USB 至 GPIO 接口仓体连接到 EVM 。 USB 至 GPIO 接口仓体将 EVM 连接至计算机 USB 端口 , 这样 TI 就能够 “融合” 图形用户界面 (GUI) , 以与 EVM 通信并对其进行控制。要下载最新的软件版本 , 请访问 http://www.ti.com.cn/tool/cn/fusion_digital_power_designer 。

ALERT 、 DATA 、 CLK 和 CNTL 测试点用于通过 PMBus 监测和控制模块。有关支持的 PMBus 命令的详细信息 , 请参阅 “TPS546C23 PG1.0 支持的 PMBus 命令” 文档。

Vout Gain 跳线 (P4) 用于设置输出电压。选择 X1 可设置 0.35V 至 1.65V 之间的输出电压 , 选择 X2 可设置 0.70V 至 2V 之间的输出电压。默认加载 X1 位置。

Comp Select 跳线 (P2) 为 VOUT 总线上的总输出电容设置适当的频率补偿。EVM 出厂时在电路板上加载了大概 2000 μ F 的输出电容。电路板上提供了用于添加另一个 2000 μ F 输出电容 (C28 - C31) 的位置。默认跳线加载 2000 μ F 位置。

当两个 TPSM846C23 器件并联时 , 必须以所需的开关频率向环路控制器和环路跟随器的 SYNC 引脚提供 50% 占空比的外部时钟信号。EVM 上存在一个 500kHz 时钟 , 可提供所需的 50% 占空比信号。环路控制器器件 (U1) 锁定到时钟的上升沿 , 环路跟随器器件 (U2) 锁定到时钟的下降沿。

电阻器 R5 、 R6 、 R7 和 R8 设置模块的 PMBus 地址。控制器模块 PMBus 地址是十进制 54 (十六进制 36) , 跟随器地址是十进制 52 (十六进制 34) 。

3 测试点说明

提供导向回路测试点和示波器探头测试点作为数字电压表 (DVM) 或示波器探头的方便连接点，以帮助评估器件。[表 3-1](#) 提供了对每个测试点的说明。

表 3-1. 测试点

VIN	输入电压监测。将 DVM 连接到该点以测量效率。
VS+	电源路径输出电压监测。将 DVM 正极引线连接到该点，用于测量线性调整率和负载调整率。
VS -	返回路径输出电压监测。将 DVM 负极引线连接到该点，用于测量线性调整率和负载调整率。
VOUT	输出电压监测。将 DVM 连接到该点和 PGND 以测量效率。
PGND	输入和输出电压监测接地。让 VIN 和 VOUT DVM 以这些接地点为基准。
VIN MON (J1)	输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点，以测量输入纹波电压。
VOUT MON (J2)	输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点，以测量输出纹波电压和瞬态响应。
AGND	模拟接地点。使用任何 AGND 测试点作为控制信号的接地基准。
ALERT	PMBus ALERT 线，用于监控 ALERT 信号。
CLK	PMBus CLK 线，用于监控 CLK 信号。
数据	PMBus DATA 线，用于监控 DATA 信号。
CNTL	控制引脚。拉至 AGND 以停止电源转换。浮动或拉至 3.3V 以启用电源转换。EVM 上有一个 3.3V 的内部 10kΩ 上拉电阻。
EXT CLK	外部时钟输入。这是 D 触发器的输入。以两倍于所需开关频率的频率应用外部时钟。在应用时钟信号之前移除 R13。
SYNC	SYNC 监测引脚。该引脚是 D 触发器的输出，可为两个器件提供时钟。
PGOOD	监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号，具有一个 3.3V 的板载 10kΩ 上拉电阻。
DIFFO	遥感差分放大器的输出
信号	波特图分析仪的信号注入点。从信号注入 CHB。
CHA	波特图分析仪的输入信号监测点
CHB	波特图分析仪的输出信号监测点
PH1	TPSM846C23 控制器器件 (U1) 的开关节点。使用非屏蔽示波器探头监测这个点。
PH2	TPSM846C23 跟随器器件 (U2) 的开关节点。使用非屏蔽示波器探头监测这个点。

备注

请参阅 [TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus 电源模块数据表](#)，了解表 3-1 中所列特性相关的绝对最大额定值。

4 操作说明

要使 EVM 工作 , 请施加 4.5V 至 15V 的有效输入电压。欠压锁定 (UVLO) 可使用 PMBus 命令编程。

输出电压的出厂设置为 0.6V。使用 PMBus VOUT_COMMAND 可在允许的 V_{OUT} 范围内对其编程。

当输出电压在已编程输出电压值的 $\pm 5\%$ 范围内时 , EVM 的电源正常 (PGOOD) 指示器将置为高电平。在 PGOOD 引脚和 3V3 引脚之间安装了一个 $10k\Omega$ 上拉电阻器 (R18) 。

TPSM846C23DEVM-807 设置为在 500kHz 下运行。时钟电路位于 EVM 的底部。时钟电路产生一个 500kHz 、 50% 占空比时钟 , 为两个器件供电。如果需要另一个开关频率 , 则必须从 EVM 底部的时钟电路中移除 R23 , 并且必须将外部时钟连接到 EXT CLK 测试点。应用到 EXT CLK 测试点的外部时钟必须是所需频率的 2 倍。该器件可同步至频率范围为 300kHz 至 1MHz 的外部时钟。请参阅产品数据表 , 了解有关同步的更多信息。

TPSM846C23DEVM-807 包括输入和输出电容器。该 EVM 为添加额外的输入和输出电容器提供了空间。添加额外的电容将改善瞬态响应。所需的实际电容将取决于特定应用的输入和输出电压条件 , 以及所需的瞬态响应。有关输入和输出电容和瞬态响应的更多信息 , 请参阅产品数据表。

该 EVM 应搭配使用 USB 至 GPIO 接口仓体 , 以实现 PMBus 上的通信。

在模块已通电时 , 不应更改跳线设置。否则 , 会发生永久性损坏。

5 性能数据

$V_{IN} = 12V$, $F_{sw} = 500kHz$, $C_{OUT} = 4 \times 47\mu F$ 陶瓷加 $4 \times 470\mu F$ 聚合物

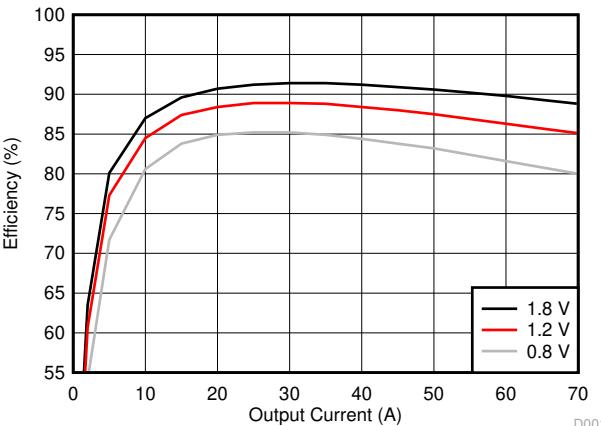


图 5-1. 效率

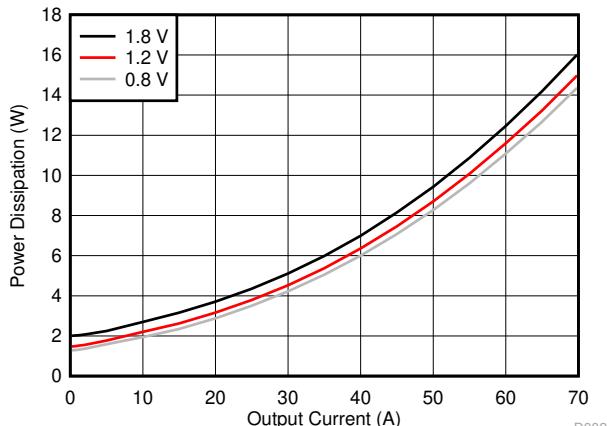


图 5-2. 功率耗散

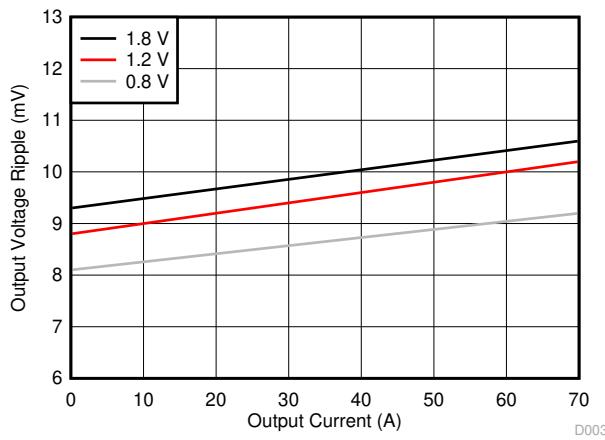
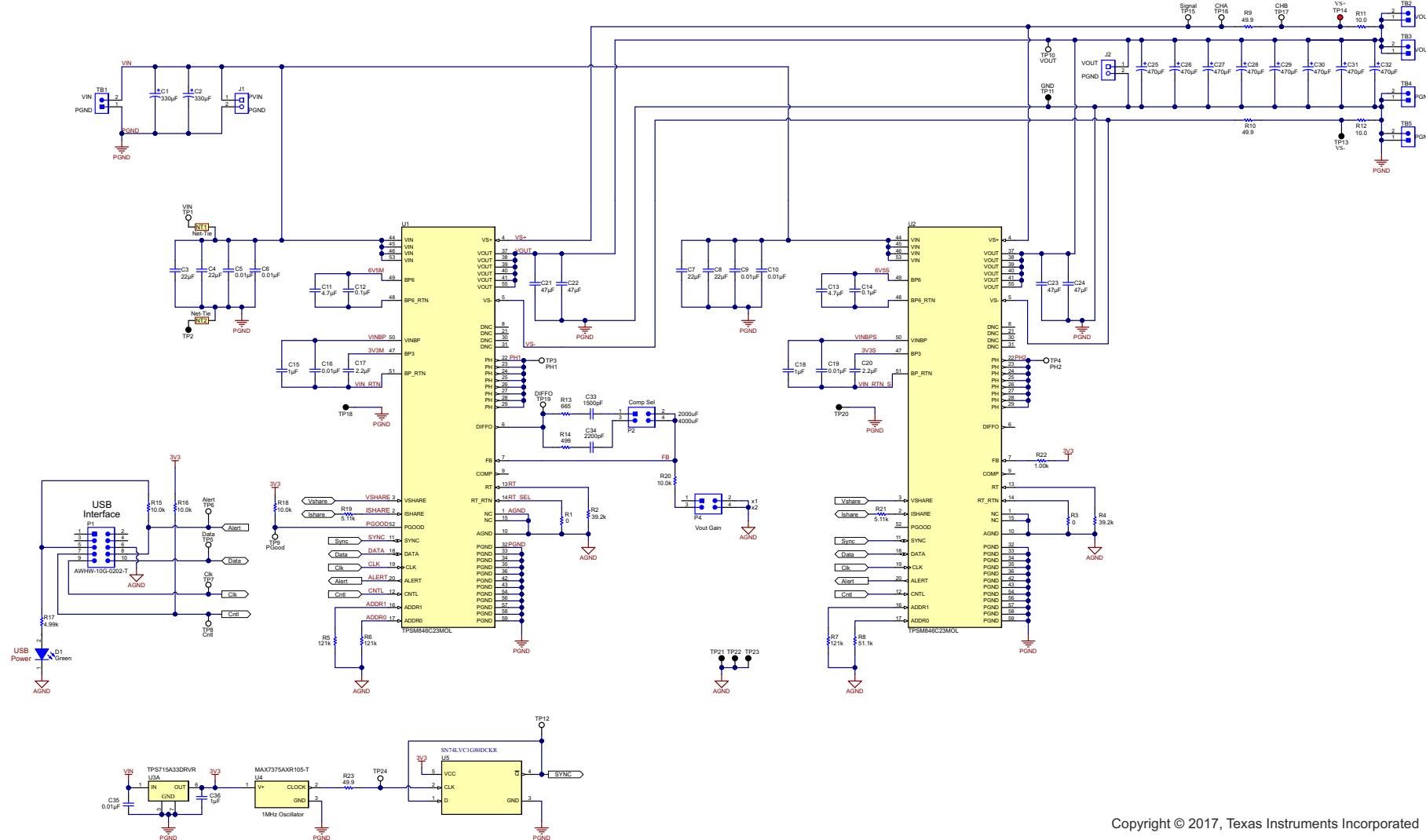


图 5-3. 输出电压纹波

6 原理图

图 6-1 演示了 TPSM846C23DEVM-807 原理图。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

图 6-1. TPSM846C23DEVM-807 原理图

7 物料清单

表 7-1 列出了 TPSM846C23DEVM-807 BOM。

表 7-1. TPSM846C23DEVM-807 物料清单

名称	数量	说明	器件型号	制造商
PCB	1	印刷电路板	—	不限
U1, U2	2	TPSM846C23	TPSM846C23MOL	德州仪器 (TI)
C1, C2	2	电容 , 铝 , 330 μ F , 25V , $\pm 20\%$, 0.053 Ω , TH	25ZL330MEFC10X12.5	红宝石 (Rubycon)
C3、C4、C7、C8	4	电容 , 陶瓷 , 22 μ F , 25V , $\pm 10\%$, X5R , 1210	GRM32ER61E226KE15L	Murata (村田)
C5、C6、C9、C10、C16、C19、C35	7	电容 , 陶瓷 , 0.01 μ F , 50V , $\pm 10\%$, X7R , 0603	GRM188R71H103KA01D	Murata (村田)
C11、C13	2	电容 , 陶瓷 , 4.7 μ F , 16V , $\pm 10\%$, X5R , 0805	GRM21BR61C475KA88L	Murata (村田)
C12、C14	2	电容 , 陶瓷 , 0.1 μ F , 16V , $\pm 10\%$, X7R , 0603	GRM188R71C104KA01D	Murata (村田)
C15、C18	2	电容 , 陶瓷 , 1 μ F , 25V , $\pm 10\%$, X7R , 0805	GRM21BR71E105KA99L	Murata (村田)
C17、C20	2	电容 , 陶瓷 , 2.2 μ F , 16V , $\pm 10\%$, X7R , 0805	GRM21BR71C225KA12L	Murata (村田)
C21、C22、C23、C24	4	电容 , 陶瓷 , 47 μ F , 6.3V , $\pm 20\%$, X5R , 1210	GRM32ER60J476ME20L	Murata (村田)
C27、C28、C31、C32	4	电容 , 钛聚合物 , 470 μ F , 6.3V , $\pm 20\%$, 0.01 Ω , 7343-40 SMD	6TPF470MAH	Panasonic (松下)
C33	1	电容 , 陶瓷 , 1500pF , 50V , $\pm 10\%$, X7R , 0402	GRM155R71H152KA01D	Murata (村田)
C34	1	电容 , 陶瓷 , 2200pF , 50V , $\pm 10\%$, X7R , 0402	GCM155R71H222KA37D	Murata (村田)
C36	1	电容 , 陶瓷 , 1 μ F , 16V , $\pm 10\%$, X7R , 0603	GRM188R71C105KA12D	Murata (村田)
C25、C26、C29、C30	0	电容 , 钛聚合物 , 470 μ F , 6.3V , $\pm 20\%$, 0.01 Ω , 7343-40 SMD	6TPF470MAH	Panasonic (松下)
D1	1	LED , 绿色 , SMD	150060GS75000	Wurth Elektronik (伍尔特电子)
J1、J2	2	插排 , 2 × 1 , 100mil , 黑色 , 锡 , TH	310-43-102-41-001000	Mill-Max
P1	1	插头 , 2.54mm , 5 × 2 , 金 , TH	AWHW-10G-0202-T	Assmann WSW
P2、P4	2	接头 , 100mil , 2x2 , 锡 , TH	PEC02DAAN	Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司)
R1、R3	2	电阻 , 0 , 5% , 0.063W , 0402	CRCW04020000Z0ED	Vishay-Dale (威世达勒)
R5、R6、R7	3	电阻 , 121k Ω , 1% , 0.063W , 0402	CRCW0402121KFKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R8	1	电阻 , 51.1k Ω , 1% , 0.063W , 0402	CRCW040251K1FKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R9、R10、R23	3	电阻 , 49.9 , 1% , 0.1W , 0603	CRCW060349R9FKEA	Vishay-Dale (威世达勒)
R11、R12	2	电阻 , 10.0 Ω , 1% , 0.1W , 0603	CRCW060310R0FKEA	Vishay-Dale (威世达勒)
R13	1	电阻 , 665 , 1% , 0.063W , 0402	CRCW0402665RFKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R14	1	电阻 , 499 , 1% , 0.063W , 0402	CRCW0402499RFKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R15、R16、R18、R20	4	电阻 , 10.0k Ω , 1% , 0.063W , 0402	CRCW040210K0FKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R17	1	电阻 , 4.99k Ω , 1% , 0.063W , 0402	CRCW04024K99FKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R19、R21	2	电阻 , 5.11k , 1% , 0.063W , 0402	CRCW04025K11FKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R22	1	电阻 , 1.00k Ω , 1% , 0.063W , 0402	CRCW04021K00FKED	Vishay-Dale (威世达勒)
R2、R4	0	电阻 , 39.2k Ω , 1% , 0.063W , 0402	CRCW040239K2FKED	Vishay-Dale (威世达勒)
TB1、TB2、TB3、TB4、TB5	5	端子块 , 30A , 9.52mm (0.375) 间距 , 2 针位 , TH	OSTT7022150	On-Shore Technology
TP1、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP12、TP15、TP16、TP17、TP19、R24	13	测试点 , 多用途 , 白色 , TH	5012	Keystone
TP2、TP11、TP13、TP18、TP20、TP21、TP22、TP23	8	测试点 , 多用途 , 黑色 , TH	5011	Keystone
TP14	1	测试点 , 通用 , 红色 , TH	5010	Keystone
TP3、TP4	0	测试点 , 多用途 , 白色 , TH	5012	Keystone
U3	1	单输出 LDO、80mA、固定 3.3V 输出、2.5V 至 24V 输入、6 引脚 SON (DRV)	TPS715A33DRV	德州仪器 (TI)
U4	1	1MHz CMOS 硅振荡器 , SOT-323	MAX7375AXR105-T	Maxim (美信)
U5	1	单路正边沿触发 D 型触发器 , (SOT-5)	SN74LVC1G80DCKR	德州仪器 (TI)

8 PCB 布局

图 8-1 至图 8-8 展示了 EVM PCB 布局图像。

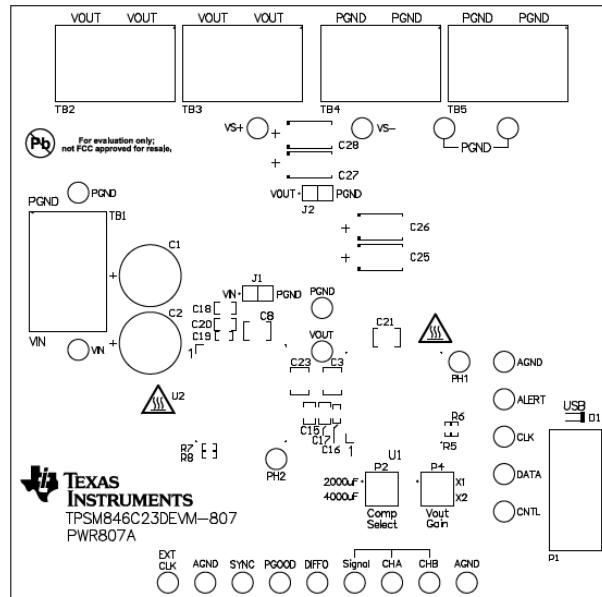


图 8-1. 顶部元件

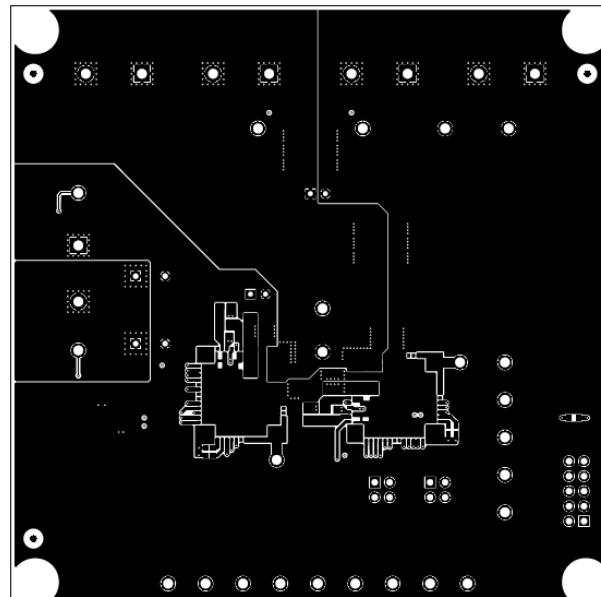


图 8-2. 顶部覆铜

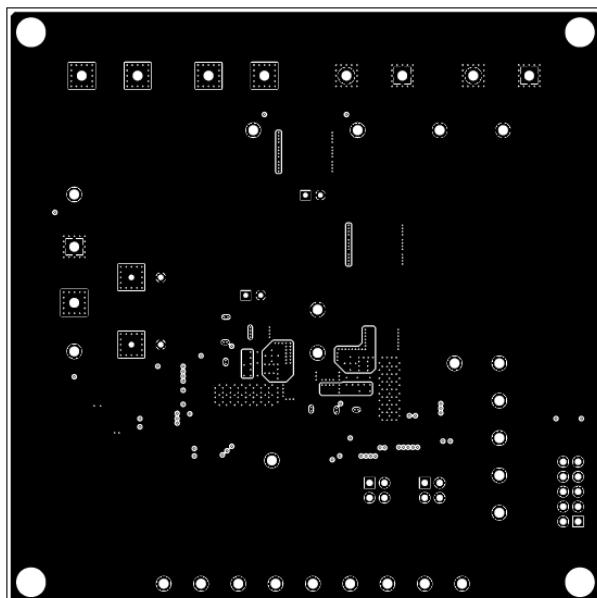


图 8-3. 第 2 层覆铜

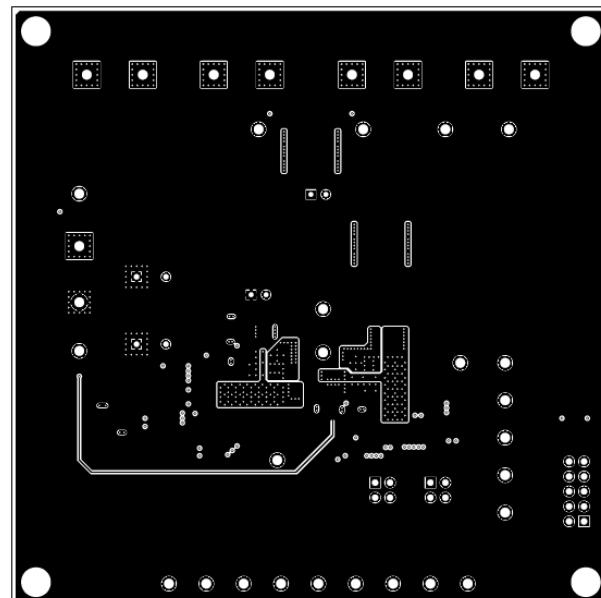


图 8-4. 第 3 层覆铜

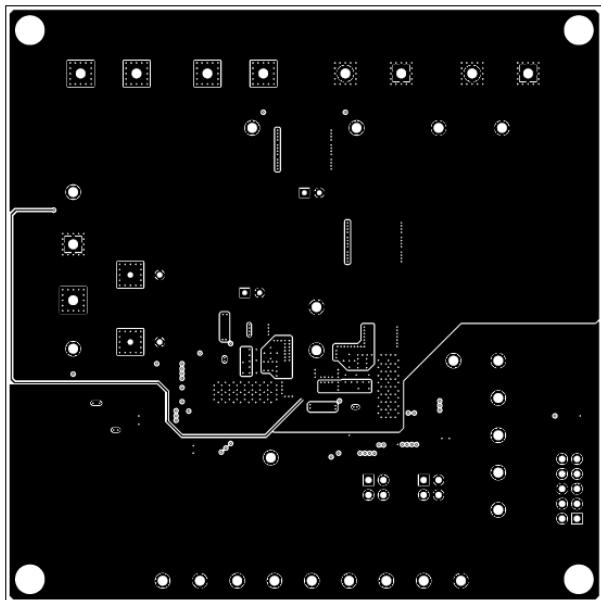


图 8-5. 第 4 层覆铜

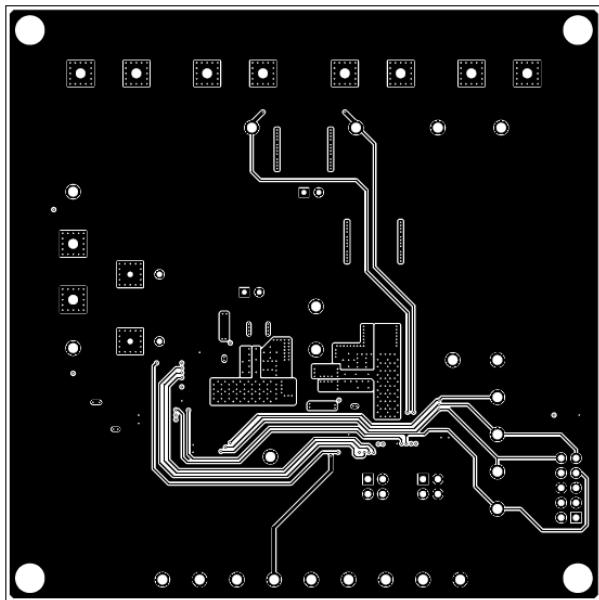


图 8-6. 第 5 层覆铜

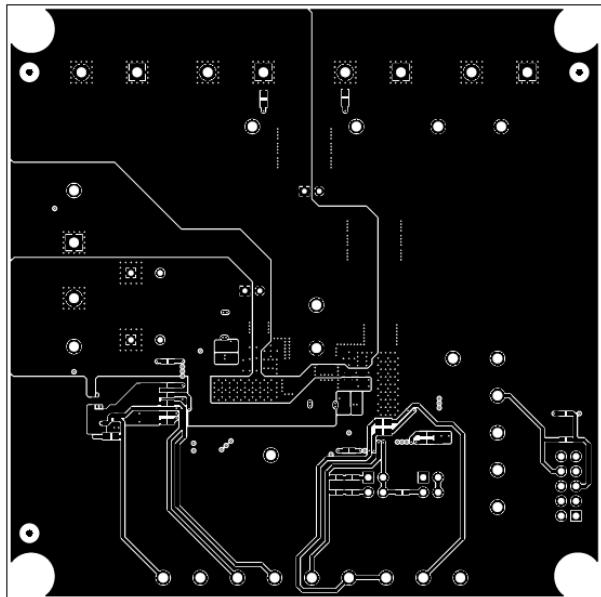


图 8-7. 底部覆铜

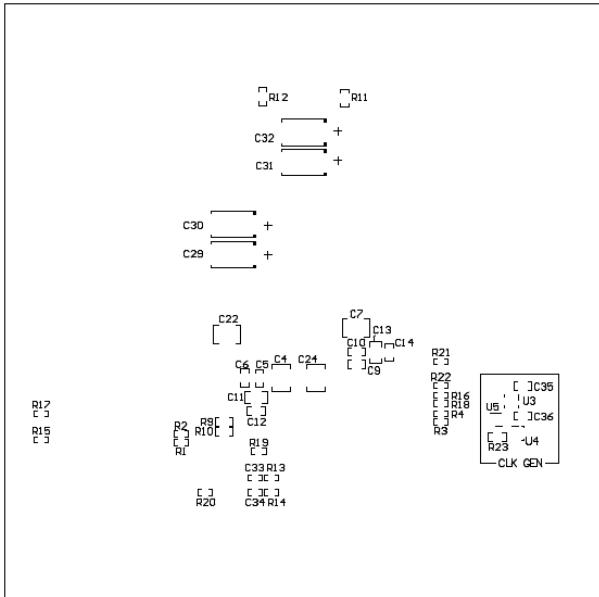


图 8-8. 底部元件

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision C (June 2018) to Revision D (February 2022)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	2
• 更新了用户指南标题.....	2
• 将提到 PMBus 的所有旧术语实例全部更改为控制器和跟随器。	2

Changes from Revision B (December 2017) to Revision C (June 2018)	Page
• 更正了电阻器基准 R18 和 R23.....	5

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022, 德州仪器 (TI) 公司